



インフィニオン テクノロジーズ 新製品のご案内



2024年3月

1	PSoC™ 車載マルチタッチ Gen6L
2	PSoC™ 車載マルチタッチ Gen6XL
3	温度センサー搭載 600 V CoolMOS™ S7T
4	CoolSiC™ MOSFET 650 V G2
5	OptiMOS™ 6 パワーMOSFET 200 V
6	ソリッド ステート アイソレーター
7	OptiMOS™ 5 パワーMOSFET 150 V、SuperSO8パッケージ
8	IGBT7搭載 PrimePACK™ 2、3+
9	OptiMOS™ 6 パワー MOSFET 120 V
10	OptiMOS™ 7 車載MOSFET向け40 V製品テクノロジー
11	OPTIREG™ リニア - TLF42772EP
12	BGA P2 プリドライバー: 無線インフラ用5 Vプリドライバー
13	OPTIGA™ TPM SLB9672 FW16
14	OPTIGA™ TPM SLB 9673
15	XENSIV™ – TISONパッケージのTLE4973車載用電流センサー

PSoC™ 車載マルチタッチ Gen6L

CYAT6165Xは静電容量式スライダークントローラーで、スライダー上の最大10本の指の位置を分解して報告するセンシングと処理技術を備えています。このタッチコントローラーは、センサーの静電容量をデジタル値に変換し、コントローラー内のタッチ検出および位置解決アルゴリズムで処理します。これらのアルゴリズムはスライダー上の各指の位置と信号の大きさを決定します。



主な特長

- > 車載電子部品評議会 (AEC) Q100 認証
- > MISRA-C / IATF 16949 準拠
- > タッチ コントローラー:
 - > 32ビット Arm® Cortex® CPU
 - > レジスタ構成可能
 - > ディスプレイとEMIのノイズ抑制技術
 - > AutoArmor
 - > スペクトラム拡散スキャン
 - > 20 V駆動と同等の効果
 - > ディスプレイの同期
 - > DualSenseを使用した耐水と濡れた指のトラッキング
 - > 自動モード切替機能付きグローブモード
 - > 低消費電力ウェイクアップ オプション
 - > ブートローダーによるフィールド アップグレード
 - > スライダー センサーのセルフテスト
 - > 製造検査キット (MTK)
- > 性能 (設定に依存):
 - > 最大48本のセンサーピン、または135個の交差点 (RX 45、TX 3)
 - > 最大250 Hzで10点タッチ
 - > グローブ (またはオーバーレイ) 最大5 mm
 - > TX周波数: 最大350 kHz
 - > 平均消費電力: 9 mW
 - > ディープスリープ電力: 11 μ W (typ.)
- > 通信:
 - > I²C 最大 400 kbps
 - > SPI 最大 8 Mbps
- > パッケージ:
 - > 64ピン TQFP 10 × 10 × 1.4 mm
 - > 56ピン QFN WF 8 × 8 × 1 mm
- > 周囲温度範囲:
 - > オートモーティブ-A: -40°C~85°C
 - > オートモーティブ-S: -40°C~105°C

主な利点

- > インフィニオンのオートモーティブ マルチタッチ ソリューションは、EMI / EMC コンプライアンス、ESD、環境変化テストだけでなく、指定されたすべての性能パラメーターを、自動化された方法 (ロボットテスト) で徹底的に試験します。開発サイクルを短縮するための検証レポートもご用意しています。
- > インフィニオンのAuto Armor技術は、自動周波数ホッピングにより、他の電子システムのTX周波数拡散によって発生するEMIによる誤タッチを防止し、電磁放射を最大30%低減することで、自動車の電気磁気適合性 (EMC) 要件を満たします。
- > Gen6Lは静電容量式ウェイクアップ ボタンをシームレスに実装します。低消費電力のウェイクアップ ボタン スキャンで50 μ A未満の動作が可能です。他のシステムコンポーネントのために電力バジェットを残すことができます。単一の集積デバイスを使用してスライダーとウェイクアップ ボタンの両方の機能を実装できるため、ボード面積とコストを削減できます。

対象アプリケーション

- > ドア制御
- > ボタン / スライダー タッチパッド
- > タッチスクリーン
- > 光学ナビゲーション
- > 静電容量式ナビゲーション
- > バイオメトリクスとナビゲーション
- > ハンズオン検出

競合製品に対する優位性

- > PSoC™車載 Gen6Lは、車載用EMC要件を満たし、開発サイクルを短縮するとともに、タッチスクリーン、タッチパッド、スライダーでの完璧なユーザー エクスペリエンスを実現します。また、低消費電力のウェイクアップボタン、フォースタッチのサポート、タッチスクリーンのカットアウトと非長方形の形状に対応しています。

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
CYAT61659-64AS48	SP005656489	PG-TQFP-64
CYAT71658-56LWS41	SP005656497	PG-VQFN-56
CYAT81658-100AS48	SP005656557	PG-TQFP-100

PSoC™ 車載マルチタッチ Gen6XL

CYAT8168X は静電容量式タッチコントローラーで、タッチスクリーン上の最大10本の指の位置を分解して報告するセンシングと処理技術を備えています。このタッチコントローラーは、センサーの静電容量をデジタル値に変換し、コントローラー内のタッチ検出および位置解決アルゴリズムで処理します。これらのアルゴリズムはタッチスクリーン上の各指の位置と信号の大きさを決定します。



主な特長

- > 車載電子部品評議会 (AEC) Q100 認証
- > MISRA-C / IATF 16949 準拠
- > タッチ コントローラー:
 - > 32ビット Arm® Cortex® CPU
 - > レジスタ構成可能
 - > ディスプレイとEMIのノイズ抑制技術
 - > AutoArmor
 - > スペクトラム拡散スキャン
 - > 20 V駆動と同等の効果
 - > ディスプレイの同期
 - > 非長方形のタッチスクリーン
 - > DualSenseを使用した耐水と濡れた指のトラッキング
 - > 自動モード切替機能付きグローブモード
 - > 低消費電力ウェイクアップオプション
 - > ブートローダーによるフィールド アップグレード
 - > タッチスクリーンセンサーのセルフテスト
 - > 製造検査キット (MTK)
- > 性能 (設定に依存):
 - > 最大スクリーンサイズ: 15インチ
 - > 最大250 Hzで10点タッチ
 - > グローブ (またはオーバーレイ) 最大5 mm
 - > TX周波数: 最大350 kHz
 - > 平均消費電力: 30 mW
 - > ディープスリープ電力: 30 μW (typ.)
- > 通信:
 - > I²C 最大 400 kbps
 - > SPI 最大 8 Mbps
- > パッケージ:
 - > 128ピン TQFP 10 × 10 × 1.4 mm
 - > 100ピン QFN WF 8 × 8 × 1 mm
- > 周囲温度範囲:
 - > オートモーティブ-A: -40°C~85°C
 - > オートモーティブ-S: -40°C~105°C

主な利点

- > インフィニオンのオートモーティブ マルチタッチ ソリューションは、EMI / EMC コンプライアンス、ESD、環境変化テストだけでなく、指定されたすべての性能パラメーターを、自動化された方法 (ロボットテスト) で徹底的に試験します。開発サイクルを短縮するための検証レポートもご用意しています。
- > インフィニオンのAuto Armor技術は、自動周波数ホッピングにより、他の電子システムのTX周波数拡散によって発生するEMIによる誤タッチを防止し、電磁放射を最大30%低減することで、自動車の電気磁気適合性 (EMC) 要件を満たします。
- > Gen6XLは静電容量式ウェイクアップ ボタンをシームレスに実装します。低消費電力のウェイクアップ ボタン スキャンで50 μA未滿の動作が可能で、他のシステムコンポーネントのために電力バジェットを残すことができます。単一の集積デバイスを使用してスライダーとウェイクアップ ボタンの両方の機能を実装できるため、ボード面積とコストを削減できます。

対象アプリケーション

- > HMIアプリケーション用ユーザーインターフェース
- > ボディコントロールとHVACアプリケーション

競合製品に対する優位性

- > PSoC™車載 Gen6Lは、車載用EMC要件を満たし、開発サイクルを短縮するとともに、タッチスクリーン、タッチパッド、スライダーでの完璧なユーザー エクスペリエンスを実現します。また、低消費電力のウェイクアップボタン、フォースタッチのサポート、タッチスクリーンのカットアウトと非長方形の形状に対応しています。

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
CYAT81688-100AS77	SP005659591	PG-TQFP-100
CYAT81688-128AS88Z	SP005659601	PG-TQFP-128

温度センサー搭載 600 V CoolMOS™ S7T

温度センサーを搭載したCoolMOS™ S7T は、容易な実装と共に、ジャンクション温度の検出精度とロバスト性を向上させます。低周波かつ大電流のスイッチングアプリケーション向けに最適化されています。ソリッドステートリレー、サーキットブレーカー設計、SMPSのライン整流に最適です。温度センサーはCoolMOS™ S7の機能を強化しており、パワートランジスタを最大限に活用できます。



主な特長

- > 高パルス電流対応
- > 最適化された価格性能
- > 低周波スイッチングアプリケーション向けに最適化
- > ソースの寄生インダクタンスを低減
- > シームレスな診断機能
- > 大電流対応
- > 高い放熱性
- > 強化された保護機能
- > サーマル デバイスの利用を最適化

主な利点

- > 導通損失を最小化
- > 高いエネルギー効率
- > 電気機械式リレー (EMR) よりも小型の設計が可能
- > 長期にわたりTCOコストを低減
- > 高い電力密度の設計が可能
- > 外部センサー部品が不要
- > パワートランジスタの最適な利用
- > 内蔵温度センサー:
 - > 精度40%向上
 - > ディスクリットセンサーソリューションより10倍高速

競合製品に対する優位性

- > 温度センサーを内蔵したSJ MOSFET、ジャンクション温度の検出精度と堅牢性を大幅に向上
- > 性能の向上: パワートランジスタの利用を最適化することにより、リレーの電力損失の低減、効率向上、出力段の制御の改善となり、性能を向上させることができます。
- > 信頼性の向上: 高い過電流しきい値を持つ出力段の高い可用性は、故障のリスクを大幅に低減し、全体的な信頼性を向上させ、お客様のメンテナンスコストを削減します。
- > 耐久性の向上: スイッチソリューションの堅牢性により、リレーの寿命が延び、交換が少なくなり、全体的なコストが削減されます。
- > 安全性の向上: 堅牢なスイッチソリューションと高い過電流しきい値により、リレーは過負荷や短絡に対する保護がさらに強化され、お客様の安全性と安心感の向上につながります。
- > エネルギーコストの削減: パワートランジスタを最大限に活用することによってリレーの消費電力を低減し、効率が向上するため、お客様のエネルギーコストを削減することができます。

対象アプリケーション

- > ソリッドステートリレー (SSR)
- > ソリッドステート サーキットブレーカー (SSCB)
- > Eヒューズ
- > モーターソフトスターター
- > 電力分配 (AC-DC)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IPT60T022S7XTMA1	SP005737937	PG-HSOF-8
IPT60T040S7XTMA1	SP005737940	PG-HSOF-8
IPT60T065S7XTMA1	SP005737943	PG-HSOF-8

【温度センサー搭載 600 V CoolMOS™ S7】

FAQ

➤ When should I use CoolMOS™ S7 devices?
> CoolMOS™ S7 is ideal when the customer is looking for a boost in efficiency without changing the design too much. Or when a more energy efficiency solution is needed in systems like relays and circuit breakers.
➤ Which applications fit CoolMOS™ S7?
> CoolMOS™ S7 is suitable for “static switching” applications. What is a “static switching” application of power MOSFETs? A system or part of it where power MOSFETs are switching at low frequency, from few time per minute to some KHz and where, consequently, the switching power losses of the MOSFET are not relevant. Examples of such applications are slow-switching sockets in rectification bridges, full bridges, low-frequency PFC for white goods as well as switches providing current breaking functionality like in solid state relay and solid-state circuit breakers.
➤ In which topologies can I use CoolMOS™ S7?
> Theoretically in any topology leg switching at low or grid frequency, plus in all solid state solutions.
➤ Can you provide an example of such topologies?
> Classic PFC, interleaved PFC and boost PFC all can use CoolMOS™ S7 in parallel to diodes for rectification purposes, obtaining a boost in efficiency. > Another example is the CCM totem-pole PFC where CoolMOS™ S7 is suitable for the low switching leg of the bridge, becoming the perfect complement to CoolSiC™ MOSFETs and CoolGaN™ HEMTs.
➤ Can I use CoolMOS™ S7 in sockets where the switching frequency is higher than 20 KHz ?
> Even if the device does not fail, the CoolMOS S7 is optimized for low frequency switching and hence at high frequency (i.e. 65 KHz) is expected that its performance degrades, and the advantages of this technology are lost. Hence, Infineon does NOT recommend to use CoolMOS™ S7 where the switching frequency is high, like for instance in the boost stage of a PFC. In this cases, suitable devices are CoolMOS™ P7, C7, G7 and CFD7.
➤ Why is CoolMOS™ S7 + EiceDRIVER™ the best solution for rectification bridges and PFC totem pole in PFC topologies?
> CoolMOS™ S7 uniquely reaches the best power density at the best price/performance for slow frequency switching applications. So, it provides the most cost effective and easier way to boost PFC efficiency, implement cost savings and high-density modular designs.
➤ Which other silicon devices can I replace with CoolMOS™ to boost efficiency?
> This depends on the application, but in general, within the low-frequency switching domain: diodes, IGBTs, TRIACs, SCRs, planar MOSFETs as well as other SJ MOSEFTs with higher $R_{DS(on)}$.
➤ Which is the max frequency I can switch the CoolMOS™ S7 with?
> There is not a precise limit because this depends on applications. However, as a rule of thumb you can assume that above 20 KHz the advantages of CoolMOS™ S7 are gradually fading away.
➤ Can I propose CoolMOS™ S7 for the design of solid-state relays (SSR) and circuit breakers (SSCB)?
> CoolMOS™ S7 is suitable for such applications, and it is generally a good fit for power SSR from 200 V to 500 V and low-voltage SSCB from 200 V to 500 V.
➤ Can I propose CoolMOS™ S7 for customers that want to replace an electro-mechanical (EM) relay or circuit breaker ?
> Yes, within the boundaries of the voltage permitted, including derating.
➤ What are the main factor against the usage of CoolMOS S7 as alternative of an electro-mechanical solution?
> These factors are mainly 3: - price, EM switches are cheap. - losses, EM switches have very low resistance. - Safety, EM switches provide contact gap so galvanic insulation of the output
➤ How can I overcome the above objections?
> Price. Relay prices are generally low but pretty constant in time, while SJ MOSFETs solid state solutions can still benefit from years of price down roadmap. On the top of this, the on-resistance of an EM switch, very small at the beginning, degrades with usage due to arcing, so an equal losses comparison with solid state alternatives appears more and more unfavorable to an EM relay while this is being used. On the top of what just said, the solid state solutions show a better TCO – total cost of ownership - than the EM counterparts. > Losses. The argument that EM losses are much lower than a solid state alternative is generally true when the solid alternative is bases on components like TRIACs, SCRs or HV planar MOSFETs. The superjunction structure of CoolMOS S7 can help reducing those losses, at a competitive price. > Output contact gap (galvanic insulation). MOSFET do not provide per se an air insulation of the output poles, as it happens in an electro-mechanical relay for instance, while the galvanic insulation between input and output circuits is normally obtainable with a reinforced insulation Infineon gate driver IC, based on the innovative coreless transformer technology. The galvanic insulation of the output poles is generally achieved by putting in series to the CoolMOS™ S7 a cheap EM relay, which is used uniquely to provide a contact gap, it does not alter the BOM and, since it opens at zero voltage, keeps the advantages of a solid state versus an EM switch. In addition, it has to be considered that the galvanic insulation of the output contacts is not always required.
➤ Most of the solid state relays and circuit breakers are nowadays using TRIACs (or SCRs), IGBT and planar MOSFETs? What are the advantages of using CoolMOS™ S7 instead?
> IGBTs are normally used for high-voltage and high-current solid-state solutions. TRIACs can cover a very wide range of power classes and are normally used for AC systems. In the 200 V – 500 V voltage range, CoolMOS™ S7 can be a perfect solution offering a reduction of power losses, a faster “intervention” time, an easier design and a consistent (40%□80%) reduction of the heat sink volume.
➤ What are the ideal system targets for solid state relays and circuit breakers?
> DC systems 200 V – 500 V > AC systems 200 V – 500 V where also power budget or space is a constraint

CoolSiC™ MOSFET 650 V G2

CoolSiC™ MOSFET 650 V G2は、 $R_{DS(on)}$ が1桁の7 mΩから50 mΩまであり、D2PAK-7、TO-247-3、TO-247-4パッケージでご利用いただけます。高い信頼性と使いやすさに優れ、駆動電圧の柔軟性が最も高い製品です。第1世代の技術がもつ強みを活かして、よりコスト最適化された、効率的でコンパクト、高信頼性のソリューションのシステム設計を加速させられます。第2世代は、AC-DC、DC-DC、DC-ACステージのすべての一般的な組み合わせに適したハードスイッチング動作とソフトスイッチングトポロジーの両方で、主要な特性値が大幅に改善されています。



主な特長

- > 優れた性能指数 (FOM)
- > 同クラスで最も低い $R_{DS(on)}$
- > 高い堅牢性と総合的な品質
- > 広い駆動電圧範囲
- > ユニポーラ駆動に対応 $V_{GS(off)} = 0$
- > 寄生ターンオン効果に対する優れた耐性
- > .XT相互接合技術によるパッケージの改善

対象アプリケーション

- > スwitching電源 (SMPS)
- > ソリッドステートサーキットブレーカー (SSCB)
- > EV充電
- > PVインバーター
- > 蓄電システム

製品関連情報/オンラインサポート

[製品ファミリーページ](#)

主な利点

- > 部品点数の削減
- > コストあたりのシステム性能を最大化
- > きわめて高い信頼性
- > 高い効率と電力密度を実現
- > 使いやすさ
- > 既存ベンダーと完全互換
- > ファンやヒートシンクを使用せずに設計可能

競合製品に対する優位性

- > きわめて低いスイッチング損失
- > 業界標準となる閾値電圧、 $V_{GS(th)} = 4.5$ V
- > 寄生ターンオンに対する堅牢性、0Vターンオフゲート電圧を印加可能
- > 柔軟な駆動電圧とバイポーラ駆動との互換性
- > ハードコミュテーションのための堅牢なボディダイオード
- > .XT相互接合技術によりクラス最高の放熱性能

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IMBG65R007M2HXTMA1	SP005912570	TO-263-7
IMBG65R015M2HXTMA1	SP005917205	TO-263-7
IMBG65R020M2HXTMA1	SP005917206	TO-263-7
IMBG65R040M2HXTMA1	SP005917207	TO-263-7
IMBG65R050M2HXTMA1	SP005917208	TO-263-7
IMW65R015M2HXKSA1	SP005917210	PG-TO247-3
IMW65R020M2HXKSA1	SP005917211	PG-TO247-3
IMW65R040M2HXKSA1	SP005917212	PG-TO247-3
IMW65R050M2HXKSA1	SP005917213	PG-TO247-3
IMZA65R015M2HXKSA1	SP005917215	PG-TO247-4
IMZA65R020M2HXKSA1	SP005882823	PG-TO247-4
IMZA65R040M2HXKSA1	SP005917216	PG-TO247-4
IMZA65R050M2HXKSA1	SP005917217	PG-TO247-4

【CoolSiC™ MOSFET 650 V G2】

FAQ

➤ **How does CoolSiC G2 650V perform compared to other vendors and G1?**

- > Generally, G2 performs very well if benchmarked with other vendors, thanks especially to very good FOMs (figures of merit). G2 also improves G1 performance, especially in switching capabilities

➤ **What are the unique selling points of CoolSiC G2 650V?**

- > Outstanding FOMs, unparalleled GOX reliability, driving voltage flexibility, .XT interconnect, granular portfolio and robust roadmap

➤ **Which topologies can be addressed with CoolSiC G2 650V?**

- > In general, SiC G2 performs very well both in hard and soft switching topologies, like PFC totem pole, LLC, HERIC, Vienna PFC...It is also recommended for multilevel topologies to address high power systems, where high efficiency targets need to be achieved

➤ **What are the advantages of top side cooling?**

- > Reduction of assembly cost and assembly automation, reduction of BOM cost, more thermal performance, longer system lifetime

OptiMOS™ 6 パワー MOSFET 200 V

新しいOptiMOS™ 6 200 V MOSFETファミリーは、インフィニオンの最新のトレンチMOSFET技術を代表する製品です。高電力密度、高効率、高信頼性のニーズに対応します。本技術は、 $R_{DS(on)}$ を大幅に低減し、その結果、導通損失を低減しています。OptiMOS™ 6 200 Vは、ゲート閾値電圧のばらつきが少なく、トランスコンダクタンスが低減されているため、並列接続に優れたデバイスです。

OptiMOS™ 6 200 Vは、穏やかなダイオード動作と低い逆回復電荷に加え、出力キャパシタンスの直線性の改善により、スイッチング損失を最低限に抑え、あらゆる動作条件においてシステム効率を向上させます。



主な特長

- > 前世代の製品と比べて:
- > $R_{DS(on)}$ を42%低減
- > 3倍ソフトなダイオードで、高いキャパシタンス直線性
- > Q_{rr} 89%低減
- > 広い安全動作領域 (SOA)
- > 鉛フリーめっき、RoHS対応

主な利点

- > 低導通損失
- > 低スイッチング損失
- > EMIを改善した安定動作
- > 並列化の必要性を低減
- > 並列動作時の優れた電流分配
- > 環境にやさしい製品

対象アプリケーション

- > モータ制御
- > SMPS
- > 太陽光発電
- > バッテリー マネジメント システム (BMS)
- > オーディオ

競合製品に対する優位性

- > 200 Vでクラス最高の性能
- > ソフトダイオード、低 Q_{rr} 、高リニア容量の組み合わせ
- > 並列接続時の電流共有の改善
- > 豊富なパッケージ展開

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISC151N20NM6ATMA1	SP005562947	PG-TDSON-8
IPT067N20NM6ATMA1	SP005562939	PG-HSOF-8
IPF067N20NM6ATMA1	SP005562927	PG-TO263-7
ISZ520N20NM6ATMA1	SP005562952	PG-TSDSON-8
IPT129N20NM6ATMA1	SP005562935	PG-HSOF-8
IPP069N20NM6AKSA1	SP005562956	PG-TO220-3
IPB068N20NM6ATMA1	SP005562848	PG-TO263-3

ソリッド ステート アイソレーター

先進的なソリッドステート アイソレーター ファミリーは、CoolMOS™、OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT、CoolSiC™などのMOS制御パワートランジスタのゲート駆動用で、ガルバニック絶縁バリアをまたいでエネルギー伝送を実現します。ソリッドステート アイソレーター ファミリーの出力側は、パワートランジスタのゲート駆動用の電圧供給が不要で、高速ターンオン/オフ、過電流保護、過熱保護などの高度な制御機能を提供し、さまざまなアプリケーション向けにソリッドステートリレーを簡単かつ安全に構築できます。



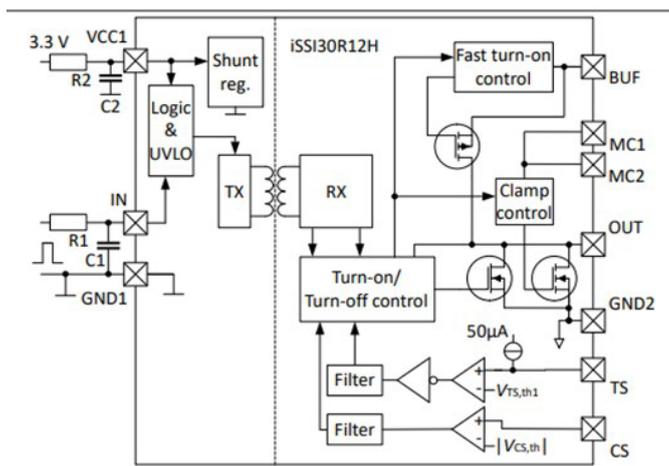
主な特長

- > ゲート駆動用絶縁ゲートバイアス電源内蔵
- > 高インピーダンス、CMOS入力
- > 高出力電圧 最大18V。強力なゲート駆動用の直列/並列構成は不要
- > 185 μ A (ダイレクトドライブタイプ) または400 mA (バッファタイプ) の高出力ピーク電流
- > 高速なターンオン/ターンオフによる安全スイッチの安全動作領域 (SOA) 動作
- > 温度センサーと電流センサーの保護入力
- > ダイナミック ミラークランプ
- > 高い面距離と空間距離のワイドボディ パッケージ (300 Mil)
- > UL 1577 / IEC 60747-17

競合製品に対する優位性

- > 電磁リレー (EMR) に対する総所有コスト
- > 体積、サイズ、部品点数、コストのBOM削減
- > システムおよびスイッチレベルの保護

ブロック図



製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISSI20R02HXUMA1	SP005739073	PG-DSO-8
ISSI20R03HXUMA1	SP005739075	PG-DSO-8
ISSI20R11HXUMA1	SP005739079	PG-DSO-8
ISSI30R11HXUMA1	SP005739083	PG-DSO-16
ISSI30R12HXUMA1	SP005739108	PG-DSO-16

主な利点

- > 可動部品がないため、高いシステム信頼性を実現
- > 絶縁バリアをまたいだエネルギー伝送
- > 絶縁電源が不要
- > ヒートシンクの必要性を最小限に
- > スイッチSOA内で安全なターンオン/ターンオフ
- > システムレベル保護: 過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)

対象アプリケーション

- > ソリッドステートリレーACおよびDCアプリケーション
- > メカニカルリレーからの置き換え
- > プログラマブル ロジック コントローラー
- > 産業オートメーション/制御
- > スマートビルおよびホームオートメーションシステム (サーモスタット、照明、暖房制御)
- > 計装機器
- > バッテリーマネージメントシステム
- > 配電キャビネット

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

【CoolSiC™ MOSFET 650 V G2】

FAQ

➤ **Are Solid State Relays (SSR) more expensive than Electromagnetic Relays (EMR)?**

- > Dependent on the use case, SSR's can be less expensive than EMR's with regards to total cost of ownership. In remote and high use applications, maintenance and system downtime could greatly increase the total cost of less reliable EMR's.

➤ **Do SSR's have high power consumption and require heat sinks?**

- > Historically, photovoltaic solutions that drive SCRs or TRIACs can have high power consumption and require large heat sinks. IFX Solid State Isolators drive MOSFETS with very low RDSon and thus lower power dissipation reducing and often eliminating the need for Heat Sinks.

➤ **What is the difference between Solid State Isolators and isolated gate drivers, and which do I promote?**

- > Solid State Isolators offers energy transfer which eliminates need for an isolated power supply on the output stage as well as integrated temperature protection.

OptiMOS™ 5 パワー-MOSFET 150 V、SuperSO8パッケージ

OptiMOS™ 5 パワー MOSFET 150 V ロジック レベル ファミリーは、OptiMOS™ 5 150 V同様の優れた性能に加え、わずか 4.5 V の V_{GS} で動作する性能を備えています。業界標準のSuperSO8パッケージで、4.5Vで非常に低い $R_{DS(on)}$ と Q_g を特長とし、小型で軽量のUSB-PD EPR充電器およびアダプタアプリケーションで最適な熱管理を実現します。



主な特長

- > 競争力のある $R_{DS(on)}$ レベル
- > きわめて低いスイッチング損失
- > $V_{GS} = 4.5 V$ に完全に最適化
- > 5 V供給の同期整流器 (SR) に対応

主な利点

- > 高効率設計
- > $V_{GS} < 10 V$ の場合は低温
- > 放熱性の改善
- > システムの複雑さを低減

対象アプリケーション

- > USB-Cアダプター&充電器
- > 家電製品の補助電源

競合製品に対する優位性

- > OptiMOS™ 5 150 Vの競争力ある $R_{DS(on)}$ と市場をリードするスイッチング性能
- > 市場の150 Vロジックレベルの代替選択肢中、最も低いFOMg
- > OptiMOS™ 5 150 Vノーマルレベルよりも低い $R_{DS(on)}$ ($V_{GS} = 4.5 V$ 時)
- > 低 V_{GS} 動作により、同期整流コントローラーの損失と温度を低減

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
BSC088N15LS5ATMA1	SP005825833	PG-TDSON-8
BSC105N15LS5ATMA1	SP005825836	PG-TDSON-8
BSC152N15LS5ATMA1	SP005825839	PG-TDSON-8

IGBT7搭載 PrimePACK™ 2、3+

TRENCHSTOP™ IGBT7技術を搭載した、ドライブおよびCAVアプリケーションがターゲットのPrimePACK™ 2、3+パッケージのIGBTモジュールを発表しました。

PrimePACK™ 2 1600 Aは、同一パッケージで電流出力が77%向上し、PrimePACK™ 3よりもフレームサイズを縮小できます。

PrimePACK™ 3+ 2400 Aは、同一フレームサイズで出力電流が37%向上し、コンバーターの定格を450 kWから710 kWまで引き上げることができます。



主な特長

- > 最新TRENCHSTOP™ IGBT7チップ技術
- > スイッチング周波数1 kHz~2.5 kHzでクラス最高レベル
- > パッケージ絶縁VISOL 4 kV
- > 高い耐湿性と耐硫化水素 (H2S)

主な利点

- > 高電力密度
- > 過負荷時175°Cで連続動作
- > 導通損失を大幅に低減
- > インバータシステムの簡素化
- > システムコストの低減

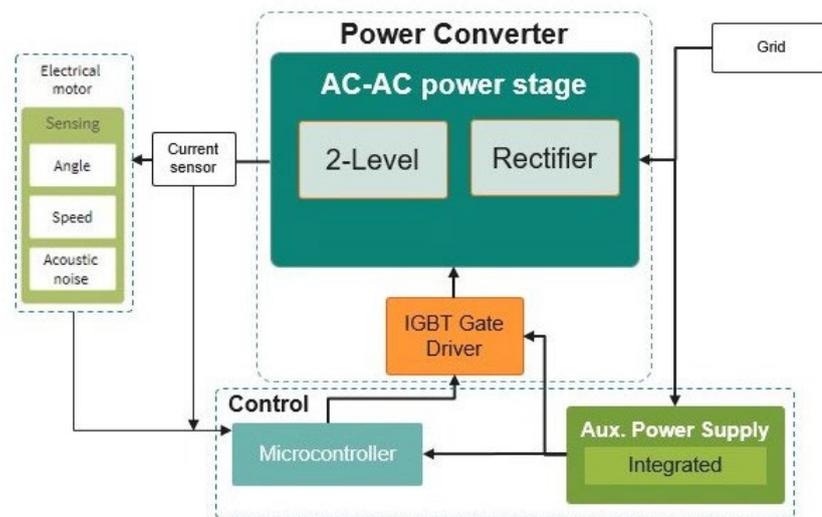
競合製品に対する優位性

- > 高電力密度製品のラインナップ拡張
- > クラス最高レベルの低い導通損失
- > FF1600R12IP7は既存のインバータープラットフォームでフレームサイズの変更が可能
- > 過負荷時175°Cで連続動作
- > 高い耐湿性と耐硫化水素 (H2S)

対象アプリケーション

- > ドライブ
- > CAV

ブロック図



製品関連情報/オンライン サポート

- [製品ページ FF1600R12IP7](#)
- [製品ページ FF2400R12IP7](#)
- [製品ページ FF2400R12IP7P](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FF1600R12IP7BOSA1	SP005411824	AG-PRIME2-731
FF2400R12IP7BPSA1	SP005418144	AG-PRIME3+-731
FF2400R12IP7PBPSA1	SP005675959	AG-PRIME3+-731

【IGBT7搭載 PrimePACK™ 2、3+】

FAQ

➤ How can IGBT7 PrimePACK™ devices help to reduce costs

- > Customers can replace parallel modules with less new ones.
- > The weight and cost of system components like heatsink, busbar, frame, base, ... is enabled to be shrinked by 30-50%
- > Less PCB components and drivers could be required.
- > Inverter current increase +35%

➤ Why is Infineon's IGBT7 specified for 175°C overload?

- > The TRENCHSTOP™ IGBT7 is developed to operate at continuous temperature of 175°C. The overload limitation is given by mechanical constrains.
- > Most of the applications are designed with an overload profile, and here the IGBT7 is the perfect fit.
- > The TRENCHSTOP™ IGBT provides the lowest static losses in comparison to other manufacturers.

OptiMOS™ 6 パワー MOSFET 120 V

完全最適化された最高クラスの性能を備えたパワー-MOSFET (120 V) インフィニオンのOptiMOS™ 6パワー-MOSFETファミリー120 Vは、ハードスイッチとソフトスイッチの両アプリケーション、また、高スイッチング周波数および低スイッチング周波数に適しており、ノーマルレベルとロジックレベルが利用可能です。産業用電源、ソーラー、充電器、低電圧モータ制御、電動工具など、さまざまなアプリケーションで使用できます。



主な特長

- > 業界で最も低い $R_{DS(on)}$ (120 V)
- > スwitching損失、導通損失において最適なバランスを実現し、様々なアプリケーションに対応
- > 150 V耐圧不要時に $R_{DS(on)}$ やFOMを低減
- > パッケージの幅広い選択肢: FR4基板およびIMS基板向け面実装、上面冷却、スルーホール
- > 産業用認証と $T_{j,max} = 175^{\circ}\text{C}$ により優れたパワーハンドリングと堅牢性を実現

主な利点

- > 高効率
- > 高い電力密度
- > 高いシステム信頼性
- > デバイスの効率化により、冷却の手間を低減し、並列デバイスの必要個数の削減でコスト削減
- > 異なるPCB素材を柔軟に選択できることによるコスト削減

競合製品に対する優位性

- > 大幅な $R_{DS(on)}$ の低減を実現し、導通損失(I^2R)を低減
- > Q_g と Q_{gd} の改善により、高速ターンオン/オフ動作を実現し、switching損失を低減
- > Q_{rr} の低下により、電圧オーバーシュートとswitching損失が減少

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

対象アプリケーション

- > 電動工具およびガーデニングツール
- > アダプターおよび高速充電器
- > 太陽光発電
- > テレコム
- > 軽電気自動車

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISC030N12NM6ATMA1	SP005578327	PG-TSON-8
ISC032N12LM6ATMA1	SP005548365	PG-TDSON-8
ISC037N12NM6ATMA1	SP005434366	PG-TDSON-8
ISC073N12LM6ATMA1	SP005586060	PG-TDSON-8
ISC078N12NM6ATMA1	SP005586109	PG-TDSON-8
ISC104N12LM6ATMA1	SP005586043	PG-TDSON-8
ISC110N12NM6ATMA1	SP005586047	PG-TDSON-8
ISC320N12LM6ATMA1	SP005586034	PG-TDSON-8
ISZ106N12LM6ATMA1	SP005586116	PG-TSDSON-8
ISZ330N12LM6ATMA1	SP005578331	PG-TSDSON-8
IPT017N12NM6ATMA1	SP005560061	PG-HSOF-8
IPTC017N12NM6ATMA1	SP005586134	PG-HDSOP-16
IPTG017N12NM6ATMA1	SP005915722	PG-HSOG-8
IPF019N12NM6ATMA1	SP005586125	PG-TO263-7

【OptiMOS™ 6 パワー MOSFET 120 V】

FAQ

➤ **Is the new OptiMOS™ 6 improving only the figures of merit of OptiMOS™ 3 in 120 V?**

- > No. The OptiMOS™ 6 technology brings not only a great improvement in the MOSFET FOMs, but also: improved softness of the body diode, massive reduction in Q_{rr} and improved avalanche energy capability.

➤ **Why does OptiMOS™ 6 have a lower R_{thjc} than OptiMOS™ 3?**

- > Improved process yields less voids and improves the technology thermal impedance model.

➤ **With the introduction of OptiMOS™ 6, will Infineon discontinue previous OptiMOS™ generation in 120 V?**

- > Infineon will not discontinue or set “not for new design” for previous OptiMOS™ generations as they address different customer requirements like general purpose MOSFET and price/performance products for industrial applications.

OptiMOS™ 7 車載MOSFET向け40 V製品テクノロジー

OptiMOS™ 7 40 Vは、インフィニオンの新しい車載用MOSFETテクノロジーです。従来のOptiMOS™ 6に比べ、Ronが25%向上しています。OptiMOS™ 7は、このように業界最小のオン抵抗で最高の電力密度とエネルギー効率を提供します。最高クラスのRon Aを実現したことで、インフィニオンは今後数年間、車載用パワーMOSFETの最先端の地位を確立します。



主な特長

- > きわめて低いドレイン-ソース間オン抵抗 ($=R_{DS(on)}$)
- > 高いアバランシェ耐量
- > 高い安全動作範囲 (SOA) 耐性
- > 高速スイッチング (ターンオン/オフ)
- > リードレスパッケージ (Cuクリップ)
- > 最先端の薄型ウェハーCuテクノロジー、および最先端の内製300mmウェハー

競合製品に対する優位性

- > OptiMOS™ 7 40 Vは、Ron A、電力密度、電流能力、スイッチング性能、チップ耐久性の面で業界のベンチマークとなるテクノロジーです。
- > さらに、インフィニオンの堅牢で定評あるパッケージ ラインナップで製品展開し、最も効率的な車載設計を実現する上面放熱パッケージにまで拡張されています。

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IAUCN04S7L004ATMA1	SP005754376	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N004ATMA1	SP005402881	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L005ATMA1	SP005754380	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N005ATMA1	SP005569114	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L006ATMA1	SP005754382	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N006ATMA1	SP005754389	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L009ATMA1	SP005754398	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N009ATMA1	SP005754400	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L011ATMA1	SP005754418	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N012ATMA1	SP005754419	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L014ATMA1	SP005754420	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N015ATMA1	SP005754421	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L019ATMA1	SP005754422	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N020ATMA1	SP005754423	PG-TDSON-8
IAUCN04S7L028ATMA1	SP005402879	PG-TDSON-8
IAUCN04S7N030ATMA1	SP005754406	PG-TDSON-8

主な利点

- > 高電力密度、高効率
- > 大電流容量
- > 高い耐久性の設計
- > 優れたスイッチング性能
- > 小型で効率的な放熱
- > 車載品質の製品設計
- > 高い車載品質の製品

対象アプリケーション

- > 電動パワーステアリング
- > 電力遮断スイッチ
- > ゾーンコントロールユニット (ZCU) およびeFuseボックス
- > DC-DCコンバーター
- > USB充電およびブレーキ
- > あらゆる車載アプリケーション
- > 幅広いBLDC制御アプリケーション

OPTIREG™ リニア - TLF42772EP

TLF4277-2EP は、リニア電圧レギュレーターと電流センスを内蔵したアクティブアンテナ電源です。新しいOPTIREG™ リニアは、400mAまでの負荷を供給できるモノリシック集積型低ドロップアウト電圧レギュレーターです。厳しい電流制限と診断が必要な重要アプリケーションへの供給に最適な、監視/保護機能とハイサイド電源スイッチを備えています。調整可能な出力電圧により、標準的なアクティブアンテナに供給することができます。



主な特長

- > 電流モニター内蔵
- > 過電圧、過温度、過電流検出
- > 調整可能な出力電圧
- > 最大400 mAの出力電流
- > 調整可能な出力電流制限
- > 1 μ Fのセラミック出力コンデンサで安定
- > 最大40 Vまでの広い入力電圧範囲
- > 逆極性保護
- > 短絡保護

主な利点

- > 堅牢な保護機能
- > 広い入力動作と温度範囲
- > 電流モニター内蔵

競合製品に対する優位性

- > 電流モニター内蔵
- > 超低消費電流
- > 非常に低いドロップアウト電圧

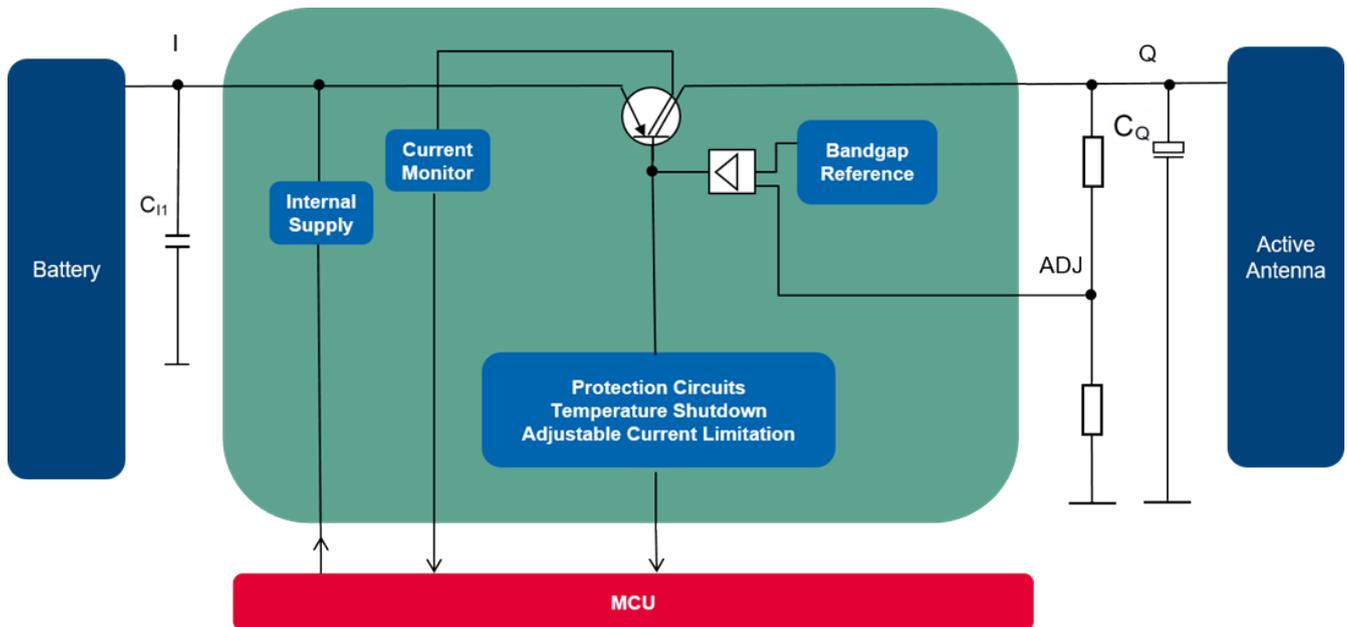
対象アプリケーション

- > 車載用センサー電源
- > 車載用テレマティクス システム
- > カメラおよびレーダー電源

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

ブロック図

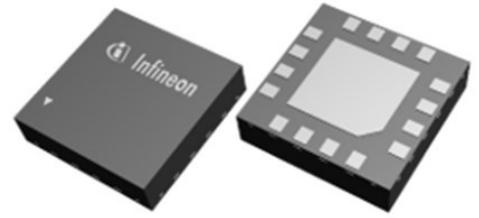


製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLF42772EPXUMA1	SP005570906	PG-TSDSO-14

BGA P2 プリドライバー: 無線インフラ用5Vプリドライバー

インフィニオンのワイヤレスインフラ用ドライバーアンプは、マッシュMIMO 5G基地局からスモールセルやアクセスポイントまで、RFアプリケーションのプリドライバーまたはドライバーとして使用できます。この小型で強力なアンプは、通常トランシーバーICとパワーアンプの間に位置しますが、低電力アプリケーションのパワーアンプとしても使用できます。ドライバーアンプは、高い直線性と優れた広帯域ゲインフラットネスを誇り、駆動PAの最適な線形化を実現します。BGA P2シリーズは電源電圧5Vで動作し、差動入力とシングルエンド入力のバリエーションがあります。



主な特長

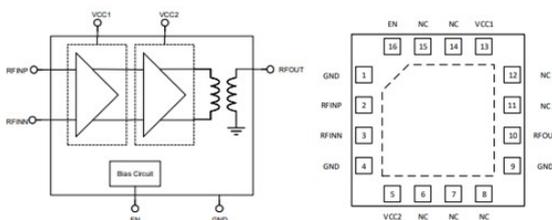
- > 電源電圧: 5V
- > ゲインフラットネス: ≤ 0.4 dB
- > 高ゲイン 35 dB
- > 高OP1dB: 28.5 dBm
- > 周波数範囲: 2.3~2.7および3.3~4.2 GHz
- > 差動入力インターフェース
- > 50 Ω 内部整合

主な利点

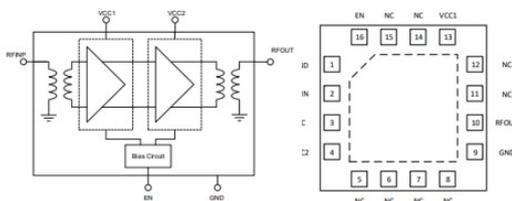
- > 性能を最適化するBiCMOS技術: BiCMOSの採用により、性能の最適化と電力効率の向上を実現
- > 高ゲイン、高出力: 28.5 dBm P1dB、35 dBゲイン: TXラインアップの部品点数を最小限に抑え、プロセス、電圧、温度によるばらつきを低減。
- > 広帯域: 2.3~2.7および3.3~4.2 GHzをカバー: 100 MHz帯域で ≤ 0.4 dBの利得平坦性を実現し、補償を簡素化
- > 内部整合: 外部整合部品不要: 外部部品が少なく、PCB面積とコストを節約

ブロック図

Differential Input Version:



Single Input Version:



対象アプリケーション

- > 5G マッシュMIMO
- > スモールセル
- > 基地局
- > 分散アンテナシステム

製品関連情報/オンラインサポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
BGAP2D20AE6327XTSA1	SP005831158	PG-TSNP-16
BGAP2D30AE6327XTSA1	SP005616724	PG-TSNP-16
BGAP2S20AE6327XTSA1	SP005831162	PG-TSNP-16
BGAP2S30AE6327XTSA1	SP005750244	PG-TSNP-16

OPTIGA™ TPM SLB9672 FW16

OPTIGA™ TPM SLB 9672 FW16.xxは、コネクテッド デバイス向けに最適化された、将来を見据えたTPMです。

拡張メモリと強力なアルゴリズムを備えており、PQCで保護されたファームウェア アップデート メカニズムを提供する市場初のTPMです。復元機能により、NIST SP 800-193ガイドラインに準拠し、TPMファームウェアを復元できます。民生グレードの品質で入手可能なTPMは、-40°C~+105°Cの温度範囲で産業用ユースケースをサポートし、寿命は最大10年です。



主な特長

- > XMSS署名によるPQC保護されたファームウェアアップグレード機構
- > 最新のTCG TPM 2.0規格 (Revision 1.59) に対応
- > TCG、CC、FIPS認証
- > 最新の暗号アルゴリズムに対応：RSA-4096まで、AES-128、AES-192、AES-256、ECC NIST P384、SHA2-384
- > 4つの保証鍵 (EK) と4つのEK証明書 (RSA 2048、RSA 3072、ECC NIST P256、ECC NIST P384) による完全なパーソナライズ機能
- > SPIインターフェース

主な利点

- > 実績のある標準化されたターンキー セキュリティ ソリューション
- > Common CriteriaとFIPS認証に基づく高い信頼性
- > 暗号処理の高速化 (機能によっては2~4倍の高速化も可能)
- > WindowsおよびLinux OSプラットフォームとの容易な統合

対象アプリケーション

- > 企業向けプリンター
- > 産業用オートメーション (工場ロボット、PLC)
- > スマートビルディング (監視カメラ)
- > ネットワークインフラ (ルーター、スイッチ、アクセスポイント、ゲートウェイ、5G機器)

競合製品に対する優位性

- > 低い実装コスト
- > 高度な攻撃に対する強力な保護
- > 厳しい産業ニーズへの適合性
- > システムの高い信頼性

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

[OPTIGA™ TPM SLB 9672 PC 評価ボードのページ](#)

[OPTIGA™ TPM 9672 RPI EVAL評価ボードのページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
SLB9672XU20FW1613XTMA1	SP005919744	PG-UQFN-32
SLB9672AU20FW1613XTMA1	SP005919746	PG-UQFN-32
TPM9672FW1523PCEBTOBO1	SP005932944	
TPM9672FW1613RPIEBTOBO1	SP006005644	

OPTIGA™ TPM SLB 9673

OPTIGA™ TPM SLB 9673は、I²Cインターフェースを備えたインフィニオンの標準化済みで、すぐに使えるセキュリティソリューションです。ネットワークインフラストラクチャや工場の堅牢性など、軽工業機械を識別/認証するための強固な基盤として機能します。プログラマブルロジックコントローラー (PLC) を識別/認証し、データの完全性と機密性を保護します。PQCで保護されたファームウェア更新メカニズム、拡張メモリ、さらに強力なアルゴリズムを備えた、製品ファミリーの最新製品は、将来的な課題にも対応します。設計作業をサポートするツールにより、製品を簡単に実装できます。OPTIGA™ TPM SLB 9673をご使用いただくことで、インフィニオン製品の長い供給期間とサポートを信頼してご利用いただけます。



主な特長

- > 最大1MHzのI2Cインターフェース
- > 最新の暗号アルゴリズムに対応：RSA-4096まで、ECC NIST P384、SHA2-384
- > TCG、CC、FIPS認証
- > TCG TPM 2.0規格 (Revision 1.59) に対応
- > XMSS署名によるPQC保護されたファームウェアアップグレード機構

対象アプリケーション

- > 企業向けプリンター
- > スマートビルディング
- > 再生可能エネルギー
- > スマートモビリティ
- > ネットワークインフラ

製品関連情報/オンラインサポート

[製品ページ](#)

[OPTIGA™ TPM 9673 RPI EVALボードページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
SLB9673AU20FW2613XTMA1	SP005919750	PG-UQFN-32
SLB9673XU20FW2613XTMA1	SP005919748	PG-UQFN-32
TPM9673FW2613RPIEBTOBO1	SP006005648	

主な利点

- > 実績のある標準化されたターンキーセキュリティソリューション
- > コモンクライテリアやFIPSの認証に基づく高い信頼性
- > 暗号演算の高速化 ((2~4倍、機能により異なる)
- > Linux OSプラットフォームとの容易な統合

競合製品に対する優位性

- > 将来的な課題に対応
- > 堅牢なセキュリティ
- > 長期的な供給とサポート
- > 容易な統合

XENSIV™ – TISONパッケージのTLE4973車載用電流センサー

TLE4973の動作電圧は5Vで、アナログ出力と過電流検出出力を備えています。1つのデジタル制御および診断インターフェースにより、温度の読み出し、安全ステータスの読み出し、内部EEPROMへアクセスし、プログラミングの読み書きが可能です。インフィニオンのホール技術は、高精度かつ高いリニアリティを持った測定が可能です。また、TISON-8-6パッケージは、組立ラインでの光学検査への対応を可能にしています。測定範囲が最大±132 Aと広く、ヒステリシスや飽和などの影響を受けることなく、電流検出を検出します。



主な特長

- > 電流経路と検出回路間のガルバニック絶縁1150 V
- > 非常に低い内部電流経路抵抗 (typ. 220 $\mu\Omega$)
- > デジタル制御および診断インターフェース
- > プログラム可能な感度および過電流閾値
- > 非常に高速な過電流検出 (反応時間 0.7 μs (typ.))
- > ASIL B、UL規格までの安全要件に対応したISO 26262準拠の開発

主な利点

- > ヒステリシスや磁気飽和がない
- > サージ電圧耐性
- > 非常に低い消費電力
- > 過電流保護
- > 感度および過電流しきい値をプログラミングし、マイクロコントローラーから診断を行うための単線インターフェース
- > 機能安全が重要なアプリケーションをサポート

対象アプリケーション

- > 電気ドライブトレイン
- > アダプターおよびチャージャー
- > オンボード バッテリー チャージャー
- > 太陽光発電システム
- > 無停電電源 (UPS)
- > バッテリー管理システム (BMS)

競合製品に対する優位性

- > 220 $\mu\Omega$ の優れた電流経路を内蔵
- > 温度および寿命に対する非常に低い感度誤差
- > 専用の超高速過電流検出経路 (標準応答時間 < 0.7 μs)
- > プログラミングおよび診断用のデジタル制御および診断インターフェース

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLE4973A025T5S0001XUMA1	SP005448257	PG-TISON-8
TLE4973A050T5S0001XUMA1	SP005448253	PG-TISON-8
TLE4973A075T5S0001XUMA1	SP005448249	PG-TISON-8
TLE4973A120T5S0001XUMA1	SP005448245	PG-TISON-8
TLE4973R025T5S0001XUMA1	SP005448239	PG-TISON-8
TLE4973R050T5S0001XUMA1	SP005448229	PG-TISON-8
TLE4973R075T5S0001XUMA1	SP005448224	PG-TISON-8
TLE4973R120T5S0001XUMA1	SP005448220	PG-TISON-8
TLE4973R025T5S0010XUMA1	SP005448202	PG-TISON-8
TLE4973R050T5S0010XUMA1	SP005448197	PG-TISON-8
TLE4973R075T5S0010XUMA1	SP005448191	PG-TISON-8
TLE4973R120T5S0010XUMA1	SP005448187	PG-TISON-8
TLE4973R025T5US0010XUMA1	SP005960607	PG-TISON-8
TLE4973R050T5US0010XUMA1	SP005960615	PG-TISON-8
TLE4973R075T5US0010XUMA1	SP005960643	PG-TISON-8
TLE4973R120T5US0010XUMA1	SP005960666	PG-TISON-8

【XENSIV™ - TISONパッケージのTLE4973車載用電流センサー】

FAQ

➤ **What sensing structure can TISON fit?**

> TISON should be preferred if the current rail is below the IC (e.g. inside the PCB)

➤ **Can I use an asymmetric sensing structure w.r.t. sensing element location ?**

> Errors due to positioning tolerances will significantly increase if the sensor is not symmetric w.r.t. the sensing structure.

➤ **Will the bandwidth for current measurement be 210kHz (typical) as stated in the datasheet?**

> The bandwidth at system level is heavily influenced by the sensing structure. 210kHz will be the bandwidth in case of an ideal sensing structure